

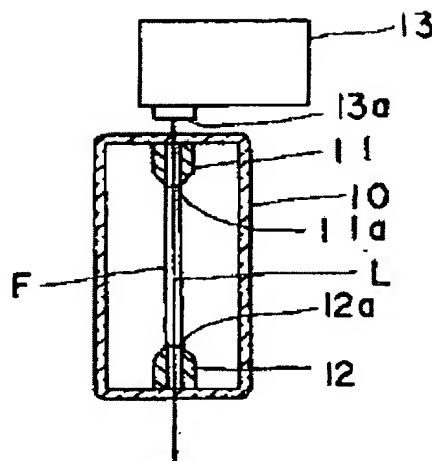
**LASER-TRIGGERED XENON FLASH LAMP**

**Patent number:** JP60136156  
**Publication date:** 1985-07-19  
**Inventor:** MINEKANE TOMIJI  
**Applicant:** TOKYO SHIBAURA ELECTRIC CO  
**Classification:**  
- **International:** H01J61/54  
- **European:** H01J61/90  
**Application number:** JP19830243730 19831226  
**Priority number(s):** JP19830243730 19831226

**Abstract of JP60136156**

**PURPOSE:** To make a starting pole needless and stabilize flash light at high brightness by lowering impedance between the anode and the cathode inside a lamp proper while generating plasma discharge between both poles along the orbit of laser light.

**CONSTITUTION:** When impressing the fixed voltage between the anode 11 and the cathode 12 inside a lamp proper 10 while discharging laser light L of high energy from a laser discharge port 13a, said laser light L instantaneously passes through the lamp proper 10 while reaching again the outer side of the lamp proper 10 from a small hole 11a through the small hole 12a. That is to say, when laser light L passes from the anode 11 to the cathode 12, an inclination is generated in potential distribution in the space between both poles and therewith impedance between both poles lowers to start plasma discharge between both poles while generating flash light L. Thereby, the starting pole between needles while stabilizing flash light at high brightness.



Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

**BEST AVAILABLE COPY**

⑫ 公開実用新案公報(U) 昭60-136156

⑬ Int. Cl.<sup>4</sup>  
H 01 L 27/04  
21/70

識別記号 庁内整理番号  
L-8122-5F  
6655-5F

⑭ 公開 昭和60年(1985)9月10日

審査請求 未請求 (全3頁)

⑮ 考案の名称 半導体装置

⑯ 実 願 昭59-24026

⑰ 出 願 昭59(1984)2月21日

⑱ 考 案 者 大 田 康 夫 大津市晴嵐2丁目9番1号 関西日本電気株式会社内

⑲ 出 願 人 関西日本電気株式会社 大津市晴嵐2丁目9番1号

⑳ 代 理 人 弁理士 江 原 省 吾 外1名

㉑ 実用新案登録請求の範囲

半導体基板上に複数段に各段毎に絶縁層を介して渦巻状金属層を順次直列接続して形成してなるインダクタンス素子を有することを特徴とする半導体装置。

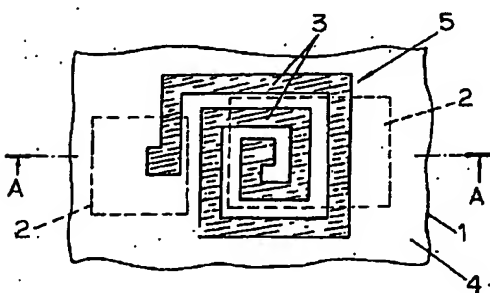
図面の簡単な説明

第1図は従来の半導体装置における半導体基板の部分平面図、第2図は第1図のA-A線に沿う断面図、第3図は本考案の一実施例を示す部分平面図、第4図は第3図のB-B線に沿う断面図、第5図は第3図の要部の概略斜視図、第6図乃至

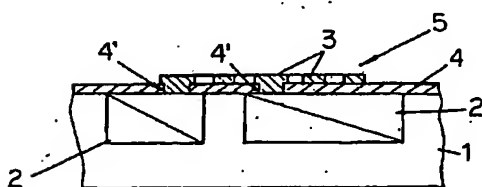
第10図は第3図におけるインダクタンス素子の製造工程例を示すもので、第6図乃至第10図の各aは部分平面図、第6図乃至第10図の各bは第6図乃至第10図の各aのC-C線、D-D線、E-E線、F-F線、G-G線に沿う断面図であり、第11図及び第12図は本考案の他の二実施例を示す各々要部の概略斜視図である。

6…半導体基板、8…インダクタンス素子、9～12…絶縁層、 $K_1$ 、 $K_1'$ 、 $K_1''$ …渦巻状金属層、 $K_2$ 、 $K_2'$ 、 $K_2''$ …渦巻状金属層。

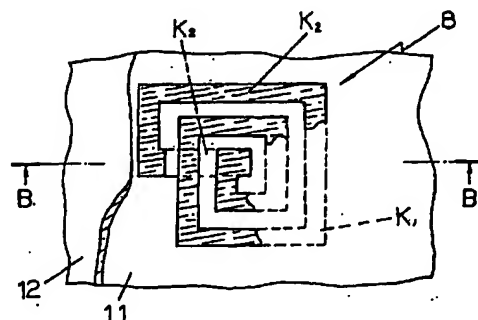
第1図



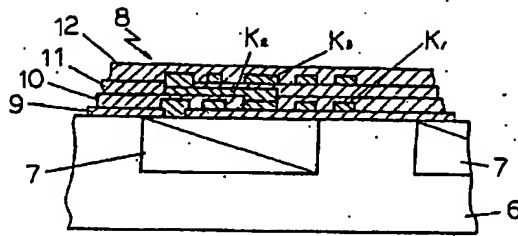
第2図



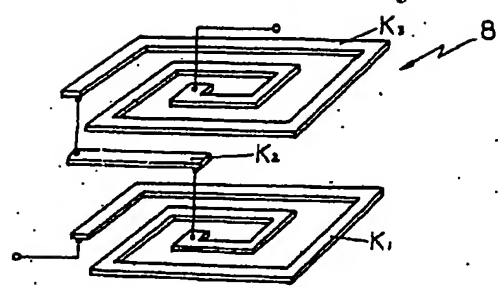
第3図



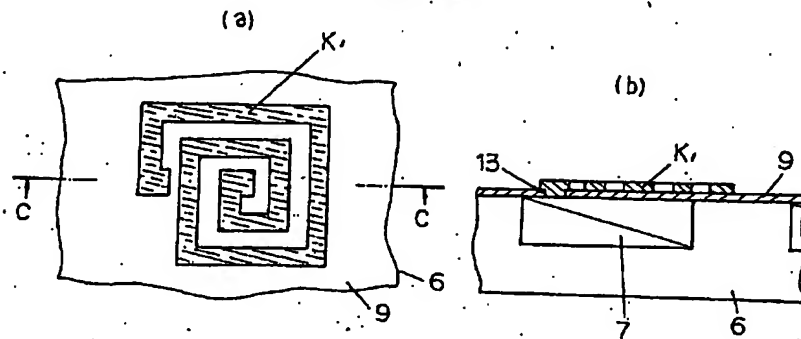
第4図



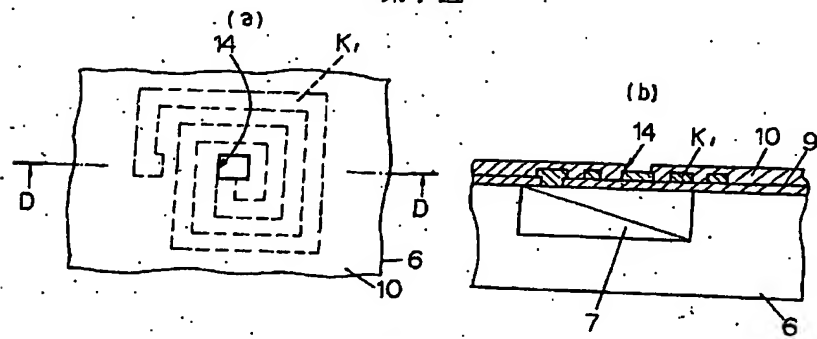
第5図



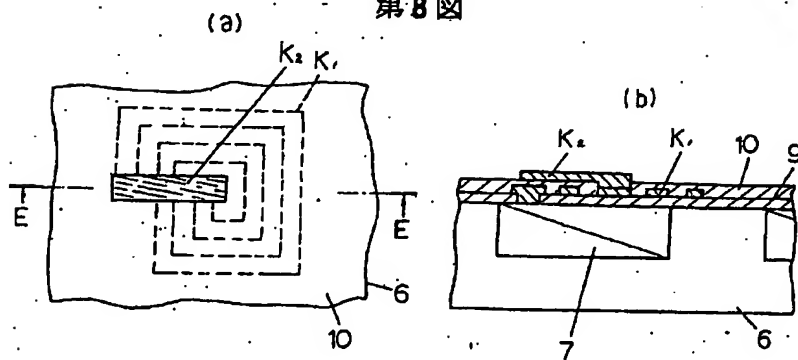
第6図



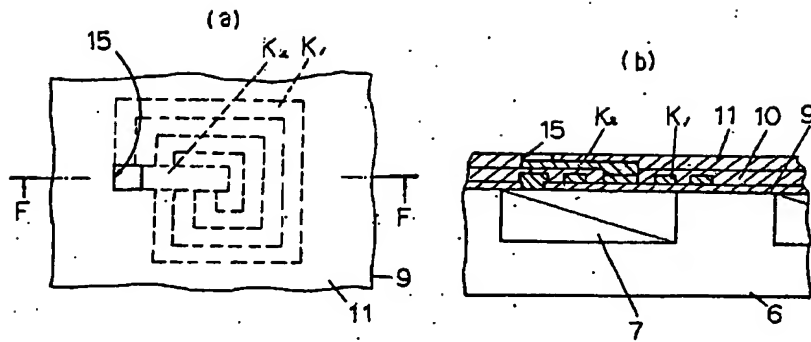
第7図



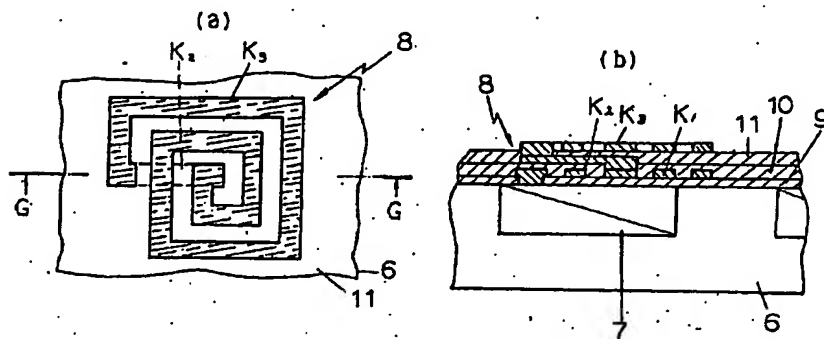
第8図



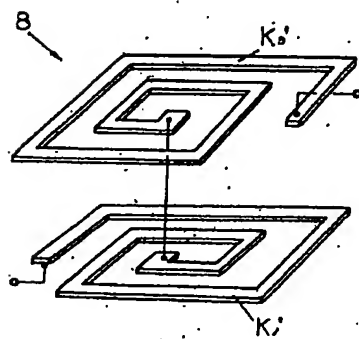
第9図



第10図



第11図



第12図

